

表 目 錄

表(1) 常見之矽微加工材料特性比較表.....	33
表(2) 常見矽微加工材料的 PECVD 機台參數與特性比較表.....	34
表(3) 殘餘應力模擬狀況參數一覽表.....	35
表(4) 殘餘應力模擬結果分析與比較表.....	35~37
表(5) 紅外線感測器浮板結構之基本規格.....	48
表(6) 各種常見之化學氣相沉積技術比較.....	53
表(7) 以 PECVD 技術沉積的氮化矽薄膜優缺點比較表.....	54
表(8) 鋁薄膜應力量測前後變化結果.....	67
表(9) 氮化矽和二氧化矽退火前後應力量測變化結果.....	70
表(10) 兩種薄膜材質經由適當比例堆疊並退火後，應力排序以及和 退火前的應力絕對值差.....	71
表(11) 分別採用表(10)中，配方(1)、(3)、(6)之混合比例，並且將鋁 膜、氮化矽薄膜以及二氧化矽薄膜三者連續沉積，得到的應 力量測結果.....	73